

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-021637

(43)Date of publication of application: 24.01.1992

(51)Int.CI.

A61K 47/36 B01J 20/26 C08B 37/08 C08F 8/30 C08J 3/12 G01N 30/48 G01N 33/543 G01N 33/548

(21)Application number: 02-122459

(22)Date of filing:

11.05.1990

(71)Applicant:

SOKEN KAGAKU KK

(72)Inventor:

MORIKAWA SHUNICHI HANADA KATSUHIRO TAKEMOTO KIYOTAKA

ARAI TAKAAKI

(54) HIGH POLYMER FINE GRAIN WHOSE SURFACE IS MODIFIED WITH CHITIN DERIVATIVE OR CHITOSAN AND ITS PRODUCTION

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain high polymer fine grains having a hydrophilic and positively ionized surface and improved in affinity to a biological high polymer by modifying the surface of high polymer fine grains with a chitin derivative or chitosan.

CONSTITUTION: High polymer fine grains having an active groups reactive with a carbodiimide compound, preferably a carboxyl latex having 0.2–10µ m grain size is made to react with a compound expressed by the formula RN=C= NR' (R is ethyl and R' is dimethylaminopropyl or R and R' are cyclohexyl together) at ordinary temperature and successively subjected to a reaction with a chitin derivative (preferably diethylaminoethylchitin) or chitosan added at ordinary temperature. The resultant modified high polymer fine grains are used as a latex for immobilization of bioaffinitive ingredient, physiologically active substance and medicine, etc., latex for immunodiagnostic agent and endotoxin removing agent.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

. [Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平4-21637

@Int. Cl. 3

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)1月24日

BLH 7624-4C 2104-4G 2104-4G ×

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全4頁)

69発明の名称

キチン誘導体又はキトサンを表面に修飾した高分子微粒子並びにそ の製造方法

> 頭 平2-122459 勿特

金出 顧 平2(1990)5月11日

外2名

勿発 委 Ш 眲

俊

埼玉県新座市栗原2-4-39

個発 明 者 在 田 克 裕

埼玉県入間市仏子603-1 32-704号

@発 明 本 溍 畫

守雄

埼玉県狭山市入間川2-24-27

②発 明 井 翠 昭 埼玉県草加市谷塚町1203

の出 頭 棕研化学株式会社 東京都豊島区高田3丁目29番5号

四代 理 人

最終頁に続く

弁理士 佐田

した高分子数粒子並びにその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. キチン誘導体又はキトサンを表面に修飾し た高分子物 粒子。
 - キチン誘導体がジエチルアミノエチルキチ ンである請求項1記載の高分子数粒子。
 - 3. 高分子数粒子がカルボキシルラテックスで ある請求項1配数の高分子微粒子。
 - 4. カルポキシルラテックス微粒子に式RN=C =NR'(式中Rはエチル基、R'はジメチルア ミノプロピル基又はR、R「は共にシクロへ キシル基を示す)を有するカルボジイミド化 合物を反応させ、次いでキチン鎌澤体又はキ トサンを反応させることを特徴とするキチン 諸導体又はキトサンを要面に修飾した高分子 微粒子の製造方法。
 - キチン関導体がジエチルアミノエチルキチ

ンである請求項4記載の高分子数粒子の製法。

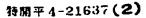
1. 発用の準細な説明:

〔産棄上の利用分野〕

本発明は、蛋白質、核酸等の生体成分の分 離精製に使用されるクロマトグラフィーの吸 着材、ドラッグ・デリバリー・システム用担 神体、免疫診断用ラテックスなどに有用なキ チン質又はキトサンを表面に修飾させた高分 子徴粒子並びにその製造方法に関する。

〔従来の技術〕

従来、抗原抗体反応を利用した免疫学的 臨床検査診断裏に疎水性表面を有するポリ スチレンラテックスが用いられている (). Calloid LaterfaceSci., 71, 356 (1979) . しかし、ポリスチレンラテックスは破水性で あるため、感作安定性、保存安定性が欠ける ため、政水性を改質するためステレンにメタ クリル酸等を共重合させた微粒子高分子の研 究、開発も行われている。



(発明が無決しようとする展題)

上記スチレンラテックスにおいては、感作 安定性、保存安定性に欠け、またメグクリル 酸等を共量合させたスチレン系ラテックスで もその感作安定性、保存安定性が十分でない ばかりでなく、これらスチレン系ラテックない においては非特異のな要異反応を育し、症 取は依件を固定化した免疫学的血清、血・ は流足中の高感度、定量分析用ラテックスとして は流足中るものではない。

本発明はラテックスを根水性に改良し、 に好選には正荷電性へ変換させて動物を 免疫を体高分子に対する側に対する の生体高分子に対する側に対する の生を高分子に対する側に対する の生を有し、ドラッグ・デリペリー・ な吸着性を有し、ドラッグ・デリペリー・ な吸着性を有し、ドラッグ・デリスリー・ なのような を受験が用ラテックを とことを目的とするものである。 (観度を解決するための手段)

本発明等はパイオアフィニティー成分、生

事体又はキトサンを反応させることを特徴と するキチン誘導体又はキトサンを表面に修飾 した高分子数粒子の製造方法である。

本発明に使用する高分子数粒子はカルボジイミド化合物と反応する活性基を有する高分子化合物であり、カルボキシルラテックスが好適である。そしてその粒径は製品の用途により適宜選択されるが、大体0.2~10点mが登流使用される。

この高分子微粒子に経飾されるキテン語導体としては、水溶性のキテン語導体、例えば、ジエテルアミノエテルキテン、カルボキンン・ヒドロキンプロビルキテン・ヒン・リン酸エステルキテン、硫酸エステルキテン・リン酸エステルキテン・ボガリンをガーに、21、13-17(1989))が最も適している。キトサンもキテンを脱アセテル化したものでキチンの構成単位であるグルコサミンを有し、しかも正賞

本発明は、キテン誘導体又はキトサンを表面に修飾した高分子徴粒子である。 そしてカルボキシルラテックス微粒子を式

RN=C=NR'(式中Rはエテル基、R'はジメ テルアミノブロビル基又はR, R'は共にシ クロヘキシル基を示す)で表わされるカルボ ジィミド化合物と反応させ、次いでキテン師

荷を有する物質であり、本発明に好適に適用 できる。

上記キチン誘導体又はキトサンを有する高分子放拉子を製造するには、カルボギシル基などの活性基を有する高分子放拉子、好適にはカルボギシルラテックス、この物質は例え



特開平 4-21637(3)

は、ステレンモノマーを単独で重合させ核粒子とした後、アクリルアミドを添加し、2級重合法により特製したステレン-アクリルアミド共富合ラテックスを加水分解することにより得られる。

この高分子数粒子に水を媒体として水溶性の一般式 RN=C=NR' (式中、R、R'は前記と同一重要を有す。)で扱わされるカルボジイミド化合物、1-エテル-3-(3-ジメテルアミノブロピル)カルボジイミドを常温でレフシクロヘキシルカルボジイミドを常温で反応させ、次にテキン解導体又はキトサンを加え約12時間位常温で反応すると本発明のキチン時導体又はキトサンを受固に修飾した高分子微粒子が得られる。

本方法におけるキチン誘導体及びキトサンの使用量は高分子のカルポキシル基に対し、 キチン誘導体又はキトサンのアミノ基として 1~8倍モル量が適当であり、4~8倍モル 量が好遇である。又、水溶性カルボジイミド

圧乾燥しジェチルアミノエチルキチン核筋
ラテックス0.58gを将た。このものの表面
荷電量は24.5μ当量/g・ラテックスであった。また、得られたラテックスの接触角
(8)は25.4であった。なお表面荷電量はコーロイド海定により測定し、接触角は自動式
PHF型接触角針で測定した。

Ø 2 ~ 3

1-エテル-3-(3-ジメテルアミノブロビル) カルボジイミド塩酸塩(TSC)及び1%ジェチルアミノエチルキチン水溶液(DEAE-キチン水溶液)を第1表に示す量加えた以外は例1と同様の操作を行い、DEAE-キチン能飾ラテックスを得た。この例の収量、表面荷電量及び接触角は第1表の通りであった。なお、1%DEAE-キチン量はラテックス中のカルボキシル基に対してDEAE-キチンのアミノ基として4倍乃至8倍モル量である。

化合物の使用量は、キチン誘導体又はキトサンのアミノ基に対し0.5~1.5倍モル量が適当であり、好適には0.8~1.2倍モル量である。

次に本発明の微粒子の製造法並びに得られた物質の性質を記載する。

(実施例)

ST 1

表面電荷量89.5 μ当量/g・ラテックス、 粒径0.6 μm、比美面被10 ml/g・ラテックス のカルボキシルラテックスの分散核(濃度 0.0157 g/mg)400mkに1-エナル-3-(3-ジメテルアミノブロビル)カルボジイミド 塩差塩0.0108 g を加え、室温で2時間浸搾 する。次いで1%ジエチルアミノエチルキ チン水溶液63 g(ラテックス中のカルボキ シル基に対してジエテルアミノエチルキナ ンのアミノ基として2倍モル量)を加え、 12 時間反応させ、次いで2 M酢酸緩固液 (PH=4) を加えて2時間浸搾し得られた 生成物を抑別する。その後水で洗浄し、減

第1表

| 实施例 | WSC (g) | 1 %DEAE- キチン水溶液 (g) | 収 重 (g) | 表面荷電量 (μ当量/8・ (ラテックス) | 接触角 (8) |
|-----|------------|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| 2 | 0,0218 | 12,6 | 0, 50 | · 152, 8 | -28.7 |
| 3 | 0.0432 | 25. 2 | 0, 70 | 142. 2 | 40.2 |

例 4 ~ 6

1%DEAE-キテン水溶液を1%キトサン水溶液に代え、TSC及び1%キトサン水溶液量を第2 芸に示す量を加えた以外は実施例1と同様の操作を行い、キトサン修飾ラテックスを得た。この例の収量、表面荷電量及び接触角は第2 表の通りであった。なお、1%キトサン水溶液量はラテックス中のカルボキシル基に対してキトサンのアミノ基として2 併乃至 8 倍 モル量である。

以下杂日

特開平 4-21637(4)



| 実済例 | wsc | 1%キトサン 水 彦 液 (g) | 权 全 (g) | 表面荷電量 (#当量/g・) ラテックス) | 接触角 (8) |
|-----|--------|------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| 4 | 0.0108 | 2. 4 | 1.03 | 12.6 | - · |
| 5 | 0.0216 | 1, 8 | 0.60 | 20.7 | 46.0 |
| 6 | 0.0432 | 9. 6 | 0.60 | 28. 6 | 61.0 |

64 7

表面荷電量38.5 μ当量/8・ラテックス、 温度9.0175 g/m2のカルボキシルラテック ス水分散液40m2を用い、 ESC 0.0052 g、 1 %DBAE-キテン水溶液3.0 g (ラテックス中 のカルボキシル当に対してDEAE-キテンの アミノ当として 2 倍モル金)加えた以外は、 実施例1 と同様の操作を行い、DEAE-キテ ン修飾ラテックス0.81 g を得た。このもの の表面荷電量は21.6 μ当量/g・ラテック スであった。

64 8

1 % DEAE-キチン水溶液を1 % キトサン水溶液1.1g(ラテックス中のカルボキシル等に対してキトサンのアミノ基として 2 倍モル量)に代えた以外は、例 7 と同様の操作を行い、キトサン修飾ラテックス0.97gを得た。このものの要面荷電量は4.3μ出量/g・ラテックスであった。

[発明の効果]

本発明は微粒子上に現水性好ましくは更に正確をも有するキチンの構成単体を持つ物質を修飾した微型子であり、これにより生体高分子に対する特異の観和性を有するためバイオアフィニティー成分、生理活性物質、系
対などの固定、免疫診断薬用ラテックス、エンドトキシン論会和として極めて広範囲の用途を有する物質を提供する有用な発明である。

特許出顧人 禁研化学株式



第1頁の続き

| A 7624—40 | ®Int. Cl. 5 | 識別記号 | 厅内整理番号 |
|--|--|-------------|--|
| C 08 F 8/30 MHA 8016-4 C 08 J 3/12 Z 7918-41 G 01 N 30/48 P 7621-2 U 7621-2 | C 08 B 37/08 C 08 F 8/30 C 08 J 3/12 G 01 N 30/48 | Z P U | 7624-4C 8016-4 J 7918-4F 7621-2 J 7621-2 J 7906-2 J 7906-2 J |